

★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)

専門委員長 大野裕三 副委員長 国清辰也

幹事 黒田理人 幹事補佐 山口 直

日時 11月6日(木) 10:00~15:30

7日(金) 10:00~14:40

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線:神谷町駅下車徒歩10分, JR:浜松町駅下車徒歩20分, 都営地下鉄三田線:御成門駅・大江戸線:赤羽橋駅下車徒歩10分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL [03] 3434-8211)

議題 プロセス・デバイス・回路シミュレーション及び一般

6日午前

1. 非対称ダブル・ゲート横型トンネル FET の解析モデルの検討
○呂 鴻飛・佐藤伸吾・大村泰久(関西大)・アブヒジット マリック(カルカッタ大)
2. Gate-on-Germanium Source (GoGeS) 縦型トンネル FET の解析モデルの検討
○大村泰久・佐藤伸吾(関西大)・アブヒジット マリック(カルカッタ大)
3. モンテカルロ法による SiC への3次元不純物イオン注入計算
○岡本 稔・清水 守・大倉康幸・山口 憲・小池秀耀(アドバンスソフト)
4. SiC パワーデバイス(DioMOS)のSPICEモデルの構築—双対性による逆方向電流のモデル化—
○山本哲也・澤井徹郎・堀川信之・神澤好彦・水谷研治・大塚信之・藤井英治(パナソニック)

6日午後

5. [招待講演] デバイス・シミュレーション—30年間の進展— 執行直之(東芝)
6. [招待講演] 計算物理に基づく電子材料設計の最近の進展 影島博之(島根大)
7. [招待講演] 電荷蓄積型メモリーのモデリング・シミュレーションと信頼性課題
○石原貴光・安田直樹・藤井章輔(東芝)

7日午前

1. [招待講演] SISPAD 2014 レビュー 園田賢一郎(ルネサス)
2. 半導体 Si 結晶育成中の点欠陥挙動に与える熱応力とドーパントの効果
○末岡浩治・神山栄治(岡山県立大)・イアン ファンヘレモント(ゲント大)
3. モンテカルロ法を用いた Si ダブルゲート構造 MOSFET の準バリスティック輸送係数の抽出
○土屋英昭・石田良馬(神戸大)・鎌倉良成・森 伸也(阪大)・宇野重康(立命館大)・小川真人(神戸大)

7日午後

4. [招待講演] ランダムテレグラフノイズの統計解析とそのモデリング 三木浩史(日立)
5. [招待講演] Interface Engineering for High Mobility Ge MOSFETs: Surface Orientation and Scattering Mechanism
○ChoongHyun Lee・Tomonori Nishimura・Akira Toriumi(Univ. of Tokyo)

◆応用物理学会共催

☆SDM 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

12月12日(金) 京大[締切済] テーマ:シリコン関連材料の作製と評価, 及びディスプレイ技術

【問合先】

国清辰也(ルネサス エレクトロニクス)

E-mail: tatsuya.kunikiyo.zn@renesas.com